

Wärmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung

R_{thJA} Min. Typ. Max. 350 K/W

Optische und elektrische Kenngrößen

$T_{amb} = 25^\circ C$

Kollektor-Dunkelstrom

$U_{CE} = 20 V, E = 0$

$I_{CEO}^*)$ 10 200 nA

Kollektor-Hellstrom

$U_{CE} = 5 V, E_A = 1 \text{ klx}^1)$

$U_{CE} = 5 V, E_e = 1 \text{ mW/cm}^2, \lambda_p = 950 \text{ nm}$

I_{ca} 6 mA

$I_{ca}^*)$ 1 2 mA

Wellenlänge der maximalen Empfindlichkeit

λ_p 780 nm

Bereich der spektralen Empfindlichkeit (50%)

$\lambda_{0,5}$ 520...950 nm

Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

$I_C = 1 \text{ mA}$

$U_{(BR)CEO}^*)$ 32 V

Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung

$I_C = 1 \text{ mA}, E_e = 1 \text{ mW/cm}^2, \lambda_p = 950 \text{ nm}$

$U_{CEsat}^*)$ 0,3 V

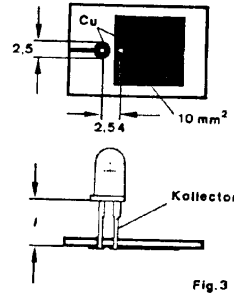
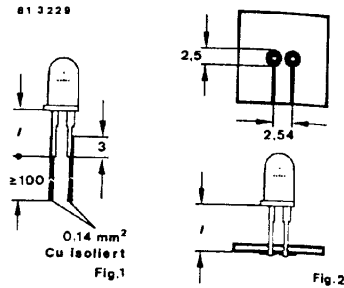
Grenzfrequenz

$U_S = 5 V, I_C = 5 \text{ mA}, R_L = 100 \Omega$

f_g 170 kHz

*) AQL = 0,65%

1) Normlichtart A (DIN 5033/IEC 306-1)

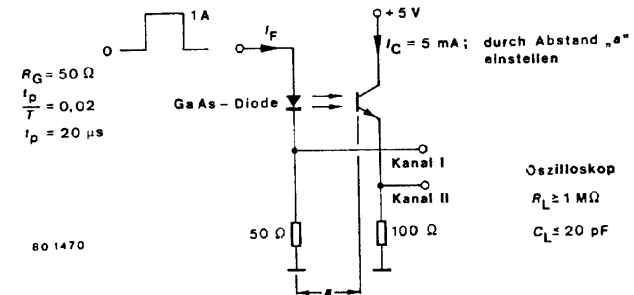


Min. Typ. Max. 350 K/W

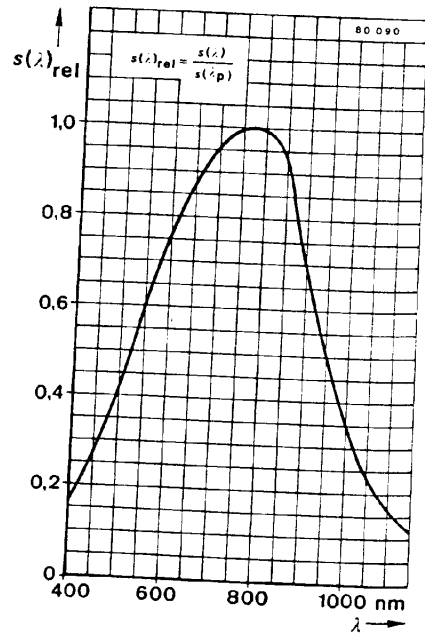
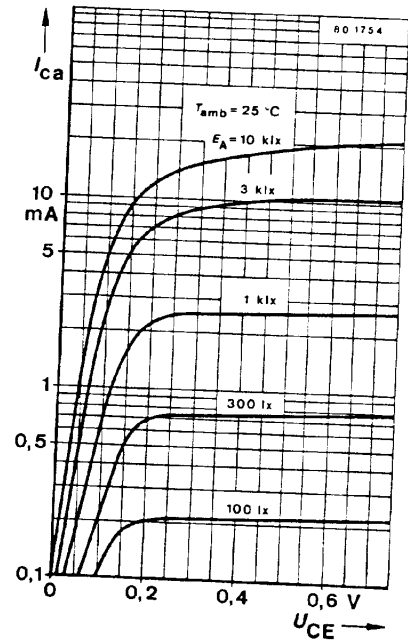
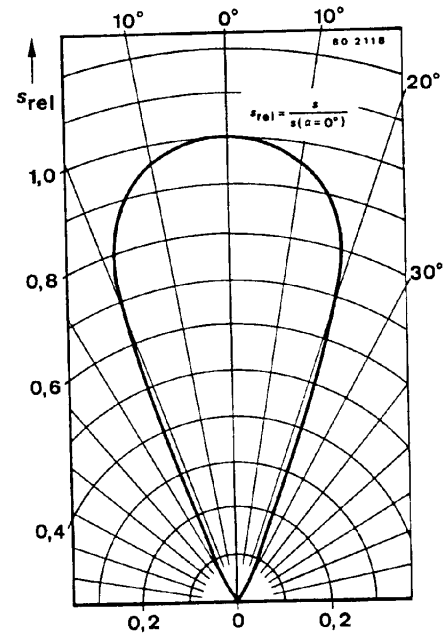
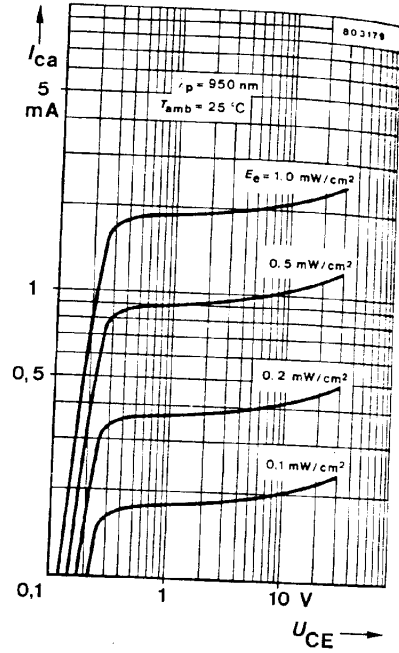
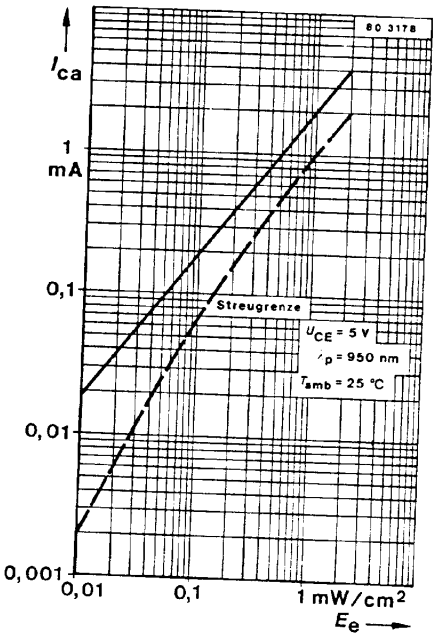
Schaltzeiten

$U_S = 5 V, I_C = 5 \text{ mA}, R_L = 100 \Omega$, siehe Meßschaltung

		Min.	Typ.	Max.
Verzögerungszeit	t_d		1,8	μs
Anstiegszeit	t_r		1,6	μs
Einschaltzeit	t_{on}		3,4	μs
Speicherzeit	t_s		0,3	μs
Abfallzeit	t_f		1,7	μs
Ausschaltzeit	t_{off}		2,0	μs

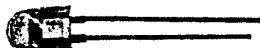


Meßschaltung





Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Fototransistor



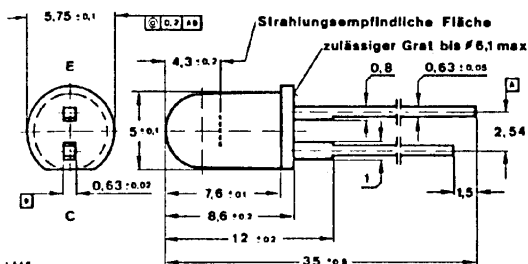
Anwendung: Empfänger in elektronischen Steuer- und Regeleinrichtungen

Besondere Merkmale:

- Kunststoffgehäuse \varnothing 5 mm
- Für die Bereiche der sichtbaren und nahen infraroten Strahlung geeignet
- Hohe Fotoempfindlichkeit
- Großer Öffnungswinkel
- Axiale Anschlüsse

Abmessungen in mm

Vorläufige technische Daten



Öffnungswinkel $\alpha = 40^\circ$

Spezialgehäuse
Kunststoff klar
Gewicht max. 0,4 g

Zubehör

Montagehülse	Best. Nr. 562 136
Haltering	Best. Nr. 562 135

Absolute Grenzdaten

Kollektor-Emitter-Sperrspannung	U_{CEO}	32	V
Emitter-Kollektor-Sperrspannung	U_{ECO}	5	V
Kollektorstrom	I_C	100	mA
Kollektorspitzenstrom	I_{CM}	200	mA
$\frac{t_p}{T} = 0,5, t_p \leq 10$ ms			
Gesamtverlustleistung	P_{tot}	100	mW
$T_{amb} \leq 45^\circ C$			
Sperrschichttemperatur	T_j	100	$^\circ C$
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	-25...+100	$^\circ C$
Maximal zulässige Löttemperatur	$T_{sd}^1)$	245	$^\circ C$
$t \leq 3$ s			

¹⁾ Abstand von der Aufsetzkante $\geq 1,5$ mm mit zwischengelegter Leiterplatte